#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文):カーボンナノチューブの各層への選択的異元素ドープ技術の開発と新機能創出を目的 とし、本研究では2層カーボンナノチュープ(DWNTs)を用いた。本研究により、外層CNTへの選択的窒素ドーピ ング、ホウ素ドーピングに成功した。窒素ドーピングでは外層CNTへドープ濃度を変化させることに成功し、窒 素ドープを施しても内層CNTへの物性的影響は少なく電気化学触媒活性を向上させるだとを確認した。また外層 CNTへの選択的ホウ素ドープにも成功し、外層CNTにホウ素ドープしても内層CNTへの構造・物性の影響が少な く、また熱電特性の向上を明らかにすることができた。

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究により、外層CNTへ選択的に窒素、ホウ素のドーピング技術の開発を行い、またドーピング後の内層CNTへ の物性変化の影響を実験的に明らかにすることができた。外層CNTへの窒素ドーピングではドーパント導入に起 因した触媒活性の向上が確認できた。また外層CNTへの選択的ホウ素ドープの技術の開発にも成功し、内層CNTへ の物性影響が少ないことを確認すると共に、熱電特性の向上を明らかにすることができた。本研究により外層へ の選択的異元素ドープによる特性向上が確認でき、今後の更なる高機能化のための足がかりとなることが期待で きる。

研究成果の概要(英文): The purpose of this study is to synthesize and characterization of wall-selectively heteroatom-doped of carbon nanotubes for functionalization and applications. For the purpose, double-walled carbon nanotubes (DWNTs) were used as the starting material. We achieved the synthesis of outer-wall selectively nitrogen(boron)-doped DWNTs. Nitrogen doping into outer tubes trigger the improvement electrochatalytic activity keeping inner tubes intact structurally. In the case of selectively boron-doping into the outer tubes, we found selective boron doping into the outer tubes improve thermoelectric properties induced by selective modulation of electric properties of outer tubes keeping properties of the inner tubes intact.

研究分野: 材料工学

キーワード: カーボンナノチューブ ドーピング

2版

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

#### 1. 研究開始当初の背景

カーボンナノチューブは優れた熱・電気・機械的な物性が明らかとなりつつ有り、その工学的な 有用性からも注目されている。また同軸2層構造からなる2層カーボンナノチューブ(DWNTs) は多層や単層カーボンナノチューブと多くの異なる特長を有した材料である。特に、DWNTsの 優れた熱安定特性、蛍光特性、機械的強度、電気伝導特性が実験的に明らかにされつつある。 DWNTs が有する同軸2層構造の構造的特長または物性的な特徴を利用した新材料開発や、電 気電子デバイスや複合材料等への展開などが期待される。今後、同軸2層構造に起因する独自 の機能・物性の発現・発見の期待が高く、さらに新たな同軸構造を利用した高機能化や工学的応 用が十分期待できる。

## 2. 研究の目的

単層や多層 CNT への異元素ドープで電気伝導性向上や高化学活性化等の機能が発現すること が知られている。同軸 2 層構造である DWNTs の構造を戦略的に利用すれば、異元素ドーピン グにより各層へドナーやアクセプタ濃度調整が見込め、革新的な機能や新物性が期待できる。し かしながら、それらを実際に検証するには、緻密に制御されたサンプルを合成し実際に特性や物 性の検証が必要である。そこで本研究では我々の研究グループが有する高純度 DWNTs 合成技 術と異元素ドープ技術を利用することで、DWNTs の各層への選択的高機能化を異元素ドープに より試み、CNT 層への構造や物性への影響を解析検証し、新しい機能発現を目的とした。

#### 研究の方法

本研究で用いた DWNTs は触媒 CVD 方により合成され、精製処理により不純物を除去したサ ンプルを使用した。高純度化した DWNTs への異元素ドープにはホウ素と窒素のドーピングを 行った。窒素ドーピングには窒素プラズマ処理をシート状の DWNTs に行うことにより窒素ド ーピングを行い、処理時間を調製することでドーピング濃度の調整を試みた。ホウ素ドーピング にはドーパント共に高温加熱することでホウ素ドープを試みた。高温加熱には黒鉛化炉を用い、 DWNTs と炭化ホウ素を黒鉛るつぼにセットし、Ar 雰囲気中で 1400 度~1600 度の加熱処理を 施すことでホウ素ドープ DWNTs を調製した。調製した各サンプルの構造解析により、DWNTs の内層外層への構造・物性への影響を解析した。

## 4. 研究成果

窒素ドープ DWNTs の合成には窒素プラズマ処理を 施すことで合成した。精製した DWNTs へ RF 電源に より窒素プラズマ(100W)を発生させ、フィルム状に した DWNTs を窒素プラズマ雰囲気下で1~10 分間処 理を行うことで、窒素ドープ DWNTs の調製を行った。 透過型電子顕微鏡 (TEM) 観察の結果、10 分間の窒素 ドーピング処理においても(図 1)、処理前と同様に DWNTs の同軸構造が観察され、またバンドル構造も 大きく変化しなかった。ここから、DWNTs の外層 CNT は窒素プラズマ雰囲気中で窒素ドープされるが、 内層 CNT は構造的にほぼ影響していないとわかる。 これは DWNTs が同軸2層構造と構造的に非常に安定 であり、本実験条件では 10 分程度では各 CNT 層に明 らかな構造変化の影響はないと分かった。図 2 に 532nm のラマン分光分析の結果を示す。ドーピング時 間の増加に伴い構造欠陥に起因する 1350cm<sup>-1</sup> 付近の D-band が増大することが分かった。一方、DWNTsの 金属的内層 CNT に起因する 270cm<sup>-1</sup> 付近の RBM が 窒素プラズマ処理後も確認され、半導体的外層 CNT に 起因する 150cm<sup>-1</sup>付近の RBM ピーク強度が大きく減 少した。ここから、窒素プラズマ処理後に外層 CNT に 窒素ドーピングが起こり外層 CNT の電子状態の変調 が起こる一方、内層 CNT は外層 CNT に保護されてお り影響が非常に少ないことが分かる。D-band の増大 から、外層に構造欠陥が導入されることも示唆される。 蛍光分光分析では、窒素ドープ DWNTs の内層 CNT からの蛍光が確認されたことから、窒素プラズマ処理 においても内層への電子構造の影響は少ないことが分



図1 外層 CNT を窒素ドープされた DWNTsの TEM 像.



図 2 窒素ドープ DWNTs のラマン スペクトル.

かった。XPS による N1s 分析の解析を行った結果 (Table1)、Pyrrolic 型窒素が処理時間と共に増加傾向 があることが分かり(1分では1.64atm%、10分では 7.46atm%)、Quaternary 型と Pyridinic 型においては 処理時間との関係性は確認されず、それぞれ 0.15~ 0.61atm%、0.14~1.08atm%であった。外層への窒素 ドーピングによる電気伝導特性と電気化学活性評価を 3 分間の窒素ドープ処理サンプルを用いて解析を行っ た(図3)。当該サンプルの水接触角を測定した結果で は 111 度から 29 度に変化し、DWNTs の外層 CNT の 窒素ドーパント導入による親水性機能の付与を確認し ている。図3は電気化学触媒活性評価を KOH 水溶液 (0.1M 酸素飽和水溶液) での RDE ボルタモグラム (1500rpm) による酸素還元反応評価である。窒素ド ーピング後では電気化学触媒活性の向上が確認でき る。また Koutecky-Levich プロットにより反応電子数 を見積もった結果、1.9 から 2.3 に増加した(-0.4V vs Ag/AgCl)。グラフェンやカーボンナノチューブへの窒 素ドープにより4電子反応が促進することが知られて いる。本実験で確認されたサンプルにおいては、期待 された触媒活性の大幅向上が確認されなかった。外層 CNT に導入された各種窒素ドーパントの存在比が影 響していると予測される。図4は窒素ドープ前後の電 気伝導特性結果を示す。窒素ドープ後には明らかに電 気抵抗率が増加していることが分かる。これはドープ された窒素がキャリアの散乱要因になっていることが 考えられ、またプラズマ処理による外層への原子欠陥 導入が電気抵抗率に影響していると考えられる。以上 の実験結果から、DWNTs の外層への選択的窒素ドー ピングに成功し、内層と外層への構造、特性の影響を 実験的に検討することができた。本実験から外層への 選択的窒素ドープを施しても、内層の構造的な影響は 少なく電子的な機能の影響も少ないと予測できた。

ホウ素ドープ DWNTs は炭化ホウ素と DWNTs を高 温加熱条件下で処理を施すことで合成を行った。高温 加熱時において黒鉛るつぼ内で DWNTs シートとドー パント源である炭化ホウ素が混入を防ぐように設置し て行った。図5にTEMによる構造解析結果を示す。 1400 度でのホウ素ドーピングにおいては DWNTs の 断面構造の影響がなく同軸構造を保持していることが 分かる。1500 度からチューブ同士の融合が始まり構造 変化の影響が大きくなることが観察される。ここから、 本実験では 1400 度の熱処理でホウ素は選択的に外層 CNT にドープされ、1500 度以上では融合現象が進む と共に内層 CNT にもホウ素ドープが進むと考えられ る。ラマン分光分析結果においては TEM 分析と同様 に 1500 度のドープ処理で構造欠陥に起因する Dband、RBM が明らかに変化していることから構造変 化が進むということが分かった。XPS 解析(Table 2) により、1400度~1600度のドープ温度において 0.17 ~0.43atm%のホウ素ドープが確認できた。B1s スペク トル分析結果から固溶置換型ホウ素は 1400 度では検 出限界以下であり、解析できなかったが 1500 度にお いては 0.11atm%であった。特に外層 CNT への選択的 ホウ素ドープが 1400 度の実験条件で予測できること から、外層には 0.11atm%よりも少ない極微量のホウ

Table 1 XPS による N<sub>1s</sub>分析結果.

| Carrala LD  | Assignment [atm%] |              |           |            |  |
|-------------|-------------------|--------------|-----------|------------|--|
| Sample I.D  | Oxidized N        | Quaternary N | Pyrrole N | Pyridine N |  |
| Pristine    | -                 | -            | -         | -          |  |
| N-DW (1min) | 0.1302            | 0.2442       | 1.637     | 0.1439     |  |
| N-DW (3min) | 0.2477            | 0.6080       | 3.710     | 1.082      |  |
| N-DW (5min) | 0.1416            | 0.1720       | 3.326     | 0.5962     |  |
| N-DW (7min) | 0.1423            | 0.1507       | 3.396     | 0.3469     |  |
| N-DW (10min | ) 0.1646          | 0.2335       | 7.455     | 0.6854     |  |



図 3 窒素ドーピング前後の酸素還 元触媒活性評価.



図 4 窒素ドーピング前後の電気抵 抗率と温度の関係.



図5ホウ素ドープDWNTsのTEM 像、(a)Pristine、(b)1400度、(c)1500 度、(d)1600度.

素が固溶置換されていると考えられる。蛍光分光分析 および紫外線可視分光光度計分析により、1400度のホ ウ素ドープ DWNTs では内層 CNT からの蛍光特性が 確認されたことから外層 CNT ヘホウ素ドープしても 内層 CNT への電子的な影響は少ないと予測できる。 1500 度においては内層 CNT からの蛍光は観察され ず、これはラマン分光分析や透過型電子顕微鏡観察結 果と一致し、 内層 CNT がホウ素ドープによる、 または CNT 間の融合現象による電子状態が大きく変化した ために消失したと考えられる。つまり、ここから 1400 度のホウ素ドープ DWNTs は外層のみに選択的にホウ 素ドープされたと示唆されている。UPS による仕事関 数を測定した結果を図 6 に示す。ホウ素ドープ処理温 度が増えるにつれて Pristine では約 4.74 eV であった 仕事関数が上昇していることが分かる。1400度ドープ では外層 CNT に正孔が生じたことを反映している。図 7に各サンプルの(a)電気伝導特性、(b)ゼーベック係数、 (c)熱伝導率の測定結果を示した。電気伝導率はホウ素 ドープ温度の上昇と共に向上していることが分かる。 これは1400度においては外層 CNT へのホウ素ドープ によるキャリア濃度の上昇が考えられ、1500度以上で はさらに内層 CNT へのホウ素ドープによるキャリア 濃度の上昇とともに TEM 観察で確認されたようなチ ューブ間の融合によるネットワーク化が影響している と考えられる。興味深いことに各サンプルのゼーベッ ク係数は 1400 度においてのみ向上していることが分 かった。これは外層 CNT のみにホウ素がドープされた ことにより外層 CNT のフェルミレベルのシフトと不 純物準位生成によるキャリア濃度が増加したことに由 ると考えられる。1500 度においては Pristine と比較し て低下が確認されたが、これは外層 CNT へのドープ濃 度の増加と共に内層 CNT へのホウ素ドープも進み、さ らに構造変化による各層 CNT の van Hove 特異点の消 失が特に影響が大きいと考えられる。さらにチューブ 間の融合により内層または外層の金属的 CNT が融合 することでネットワーク化が起こり、ゼーベック係数 の低下に繋がったのではないかとも考えられる。熱伝 導率測定結果において Pristine では 5.15(W/mK)であ ったが、1400度ドープでは 8.69(W/mK)、1500度では 8.84(W/mK)、1600 度では 7.77(W/mK)となり実際に 熱伝導率の向上が確認されたことからもチューブ間の ネットワーク化が生じたことが分かる。以上の実験結 果から、DWNTs の外層 CNT への選択的ホウ素ドーピ ングに成功し、内層 CNT の特性変化を起こすことな く、外層 CNT の電子的特性の変化が確認できた。

Table 2 ホウ素ドープ DWNTs の XPS による分析結果.

|                            |                 | Elemental analysis (at.%) |                  |          |  |  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------|--|--|
| I.D.                       |                 | С                         | 0                | В        |  |  |
| DWCNTs                     |                 | 98.82                     | 1.18             | -        |  |  |
| B1400-DWCNTs               |                 | 98.51                     | 1.32             | 0.17     |  |  |
| B1500-DWCNTs               |                 | 98.45                     | 1.19             | 0.36     |  |  |
| B1600-DWCNTs               |                 | 98.23                     | 1.34             | 0.43     |  |  |
|                            |                 |                           |                  |          |  |  |
| Boron configuration (at.%) |                 |                           |                  |          |  |  |
| B <sub>4</sub> C           | BC <sub>3</sub> | BC <sub>2</sub> O         | BCO <sub>2</sub> | $B_2O_3$ |  |  |
| -                          | -               | -                         | -                | -        |  |  |
| -                          | -               | -                         | -                | -        |  |  |
| 0.11                       | 0.10            | 0.04                      | 0.04             | 0.06     |  |  |
| 0.29                       | 0.08            | 0.06                      | -                | -        |  |  |



図 6 UPS 分析によるホウ素ドー プ DWNTs の仕事関数の変化.



図 7 ホウ素ドープ DWNTs の(a) 電気伝導率、(b)ゼーベック係数、(c) 熱伝導率の変化.

## 5.主な発表論文等

#### 〔雑誌論文〕 計8件(うち査読付論文 8件/うち国際共著 6件/うちオープンアクセス 1件) 4.巻 1.著者名 Yu-Mi Ha, Young-O Kim, Young-Nam Kim, Jaewoo Kim, Jae-Suk Lee, Jae Whan Cho, Morinobu Endo, 175 Hiroyuki Muramatsu, Yoong Ahm Kim, Yong Chae Jung 5.発行年 2. 論文標題 Rapidly self-heating shape memory polyurethane nanocomposite with boron-doped single-walled 2019年 carbon nanotubes using near-infrared laser 3. 雑誌名 6.最初と最後の頁 Composites Part B 107065 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1016/j.compositesb.2019.107065 有 オープンアクセス 国際共著 オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 該当する 1.著者名 4.巻 Hiroyuki Itoi, Hiroyuki Muramatsu, Michio Inagaki q 5 . 発行年 2. 論文標題 Constraint spaces in carbon materials 2019年 3.雑誌名 6.最初と最後の頁 RSC Advances 22823-22840 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1039/c9ra03890f 有 オープンアクセス 国際共著 オープンアクセスとしている(また、その予定である) 1. 著者名 4.巻 Jia-Wern Hue, Thomas Ch Hirschmann, Yoong Ahm Kim, Hiroyuki Muramatsu, Newton M. Marbosa Neto, 158 Paulo T. Araujo 2. 論文標題 5.発行年 Environmental effects, interactions and bond re-hybridization in bundles of double- and 2020年 triple-walled carbon nanotubes 6.最初と最後の頁 3.雑誌名 Carbon 651-661 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1016/j.carbon.2019.11.037 有 オープンアクセス 国際共著 オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 該当する 1.著者名 4.巻 Muramatsu Hiroyuki, Takahashi Masahiro, Kang Cheon-Soo, Kim Jin Hee, Kim Yoong Ahm, Hayashi 10 Takuya 2.論文標題 5.発行年 Synthesis of outer tube-selectively nitrogen-doped double-walled carbon nanotubes by nitrogen 2018年 plasma treatment 3.雑誌名 6.最初と最後の頁 Nanoscale 15938 ~ 15942 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1039/c8nr03745k 有 国際共著

該当する

オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難

オープンアクセス

| 1.著者名<br>Silva-Santos S.D.、Alencar R.S.、Agu<br>San-Miguel A.、Souza Filho A.G.       | 4 . 巻<br>nard N.P.、 141  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| 2.論文標題<br>From high pressure radial collapse t                                      | 5.発行年<br>n nanotubes 2019年   |                            |  |
| 3.雑誌名<br>Carbon   | 6 . 最初と最後の頁<br>568~579   |                            |  |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別<br>10.1016/j.carbon.2018.09.076                               | 査読の有無<br>有<br>有  |                            |  |
| オープンアクセス<br>オープンアクセスでは  | ない、又はオープンアクセスが困難   | 国際共著 該当する                  |  |
|   |  |                            |  |
| 1.著者名<br>Muramatsu Hiroyuki、Kang Cheon-Soo、<br>Hoon、Hong Seungki、Kim Yoong Ahm、H    | Fujisawa Kazunori, Kim Jin Hee, Yang Cheol-Min,<br>ayashi Takuya   | 4.巻<br>Kim Ji 3            |  |
| 2 . 論文標題<br>Outer Tube-Selectively Boron-Doped D<br>Applications                    | 2.論文標題<br>Outer Tube-Selectively Boron-Doped Double-Walled Carbon Nanotubes for Thermoelectric<br>Applications |                            |  |
| 3 . 雑誌名<br>ACS Applied Nano Materials   |  | 6 . 最初と最後の頁<br>3347 ~ 3354 |  |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別<br>10.1021/acsanm.0c00075                                     | 子)   | 査読の有無<br>有                 |  |
| オープンアクセス<br>オープンアクセスでは  | 国際共著<br>該当する   |                            |  |
|   |  |                            |  |
| 1 . 著者名<br>Sharma Keshav、Costa Nathalia L.、Ki<br>Martins Luiz G.?P.、Kong Jing、Pasch | m Yoong Ahm、Muramatsu Hiroyuki、Barbosa Neto Ne<br>oal Alexandre Rocha、Araujo Paulo T.                          | 4.巻<br>vton M.、 125        |  |
| 2 . 論文標題<br>Anharmonicity and Universal Response<br>Hydrostatic Pressure            | 5 . 発行年<br>der 2020年   |                            |  |
| 3.雑誌名<br>Physical Review Letters  | 6.最初と最後の貞<br>105501-1~7  |                            |  |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別<br>10.1103/PhysRevLett.125.105501                             |  |                            |  |
| オープンアクセス  | 国際共著   |                            |  |
| オーフノアクセスでは<br>(学会発表) 計0件  | いない、 スはクー ノノナク ヒスか 困難  |                            |  |
|   |  |                            |  |
| 〔産業財産権〕   |  |                            |  |
| 〔その他〕   |  |                            |  |
| -   |  |                            |  |
| C 研究组织  |  |                            |  |
| 0. 研先組織       氏名       (ローマ字氏名)       (研究者番号)                                       | 所属研究機関・部局・職<br>(機関番号)  | 備考                         |  |
| 林卓哉信州   | 大学・学術研究院工学系・教授   |                            |  |
| 研<br>究<br>分 (Havashi Takuva)  |  |                            |  |
| 担   |  |                            |  |

(80313831)

(13601)

# 7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

# 8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

| 共同研究相手国 | 相手方研究機関                       |      |                   |  |  |
|---------|-------------------------------|------|-------------------|--|--|
| 韓国      | Chonnam National University   | KIST | Konkuk University |  |  |
| 米国      | University of Alabama         |      |                   |  |  |
| プラジル    | Federal University of Para    |      |                   |  |  |
| 韓国      | Chonnam National University   |      |                   |  |  |
| ブラジル    | Universidade Federal do Ceara |      |                   |  |  |